

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成22年11月18日 (2010.11.18)

【公開番号】特開2009-94115(P2009-94115A)

【公開日】平成21年4月30日 (2009.4.30)

【年通号数】公開・登録公報2009-017

【出願番号】特願2007-260569(P2007-260569)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/3065 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/302 1 0 4 H

【手続補正書】

【提出日】平成22年10月1日 (2010.10.1)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板から高ドーズイオンが注入されたレジストを除去する除去工程を有し、
前記除去工程は、
少なくとも酸素分子及び水素分子を含む反応ガスをプラズマ処理し、基板からレジスト中の有機成分を除去する第 1 の除去工程と、
前記第 1 の除去工程に続いて、少なくとも水素分子を含む反応ガスをプラズマ処理し、基板からドーパント析出物を除去する第 2 の除去工程と、
を有する半導体装置の製造方法。

【請求項 2】

前記第 2 の除去工程は、酸素を含む反応ガスをプラズマ処理する請求項 1 記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 3】

前記第 2 の除去工程は、10 パーセント以下の酸素を含む反応ガスをプラズマ処理する請求項 1 記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 4】

高ドーズイオンが注入されたレジストを有する基板を載置するサセプタを有し、供給されたガスをプラズマ化される処理室と、
ガス供給設備を介して前記処理室に供給するガスの流量を制御する流量制御部と、
前記処理室からガスを排気する排気装置と、
前記処理室に供給された、少なくとも酸素分子及び水素分子を含む反応ガスをプラズマ処理し、基板からレジスト中の有機成分を除去する第 1 の除去工程を制御し、
前記第 1 の除去工程に続いて、前記処理室に供給された少なくとも水素分子を含む反応ガスをプラズマ処理し、基板からドーパント析出物を除去する第 2 の除去工程を制御する制御部と
を有する基板処理装置。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の名称】半導体装置の製造方法及び基板処理装置